

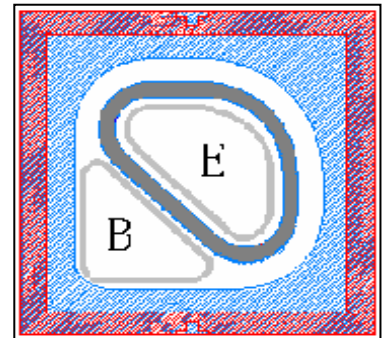


9014 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：C035BJ-00
芯片厚度： $240 \pm 20 \mu\text{m}$
管芯尺寸： $350 \times 350 \mu\text{m}^2$
焊位尺寸：B 极 $12150 \mu\text{m}^2$ ，E 极 $16180 \mu\text{m}^2$
电极金属：铝
背面金属：金
典型封装：SS9014，H9014

管芯示意图



极限值 ($T_a=25$) (封装形式：TO-92)

T_{stg} ——贮存温度.....-55~150
 T_j ——结温.....150
 P_C ——集电极耗散功率.....450mW
 V_{CBO} ——集电极—基极电压.....50V
 V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....45V
 V_{EBO} ——发射极—基极电压.....5V
 I_C ——集电极电流.....150mA

电参数 ($T_a=25$) (封装形式：TO-92)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			0.05	μA	$V_{CB}=30\text{V}$ ， $I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			0.05	μA	$V_{EB}=5\text{V}$ ， $I_C=0$
h_{FE}	直流电流增益	60		800		$V_{CE}=5\text{V}$ ， $I_C=1\text{mA}$
$V_{CE}(\text{sat})$	集电极—发射极饱和电压			0.3	V	$I_C=100\text{mA}$ ， $I_B=5\text{mA}$
$V_{BE}(\text{sat})$	基极—发射极饱和电压			1.0	V	$I_C=100\text{mA}$ ， $I_B=5\text{mA}$
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	50			V	$I_C=100\mu\text{A}$ ， $I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	45			V	$I_C=1\text{mA}$ ， $I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	5			V	$I_E=100\mu\text{A}$ ， $I_C=0$
f_T	特征频率	150			MHz	$V_{CE}=5\text{V}$ ， $I_C=10\text{mA}$